



高温整流二极管芯片产品说明书

一、芯片特点

- 1、采用沟槽氮化硅玻璃烧结工艺。
- 2、正向压降低，功耗小。
- 3、高温 200℃ 下反向漏电流小。
- 4、浪涌电流能力强。
- 5、芯片双面镍钛银金属化，牢固度强。
- 6、与正向芯片配合易于组装成三相桥电路。



二、主要用途：用于制作各种高温整流二极管，用于各种电器、电机及电子电路中整流用。

三、主要电特性：

| 型号 | 最大正向电流 I_F (A) | 最大反向重复峰值电压 V_{RRM} (V) | 最大浪涌电流 I_{FSM} (A) | 最大峰值电压 V_{FM} (V) | 最大反向漏电流 | | 少子寿命 τ (s) | 工作结温 T_{jm} (°C) | 备注 |
|------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | I_{R1} (μ A) (25°C) | I_{R2} (mA) (200°C) | | | |
| Φ6 正向芯片 | 10 | >600 | 200 | ≤ 1.1 | <5 | <2 | <30 | -55~ 200 | 芯片详细特性、外形尺寸以各芯片的规格书为准。 |
| Φ6 反向芯片 | 10 | >600 | 200 | ≤ 1.1 | <5 | <2 | <30 | | |
| Φ9 正向芯片 | 40 | >600 | 800 | ≤ 1.2 | <10 | <20 | <30 | | |
| Φ9 反向芯片 | 40 | >600 | 800 | ≤ 1.2 | <10 | <2 | <30 | | |
| Φ11 正向芯片 | 60 | >1200 | 900 | ≤ 1.2 | <20 | <3 | <40 | | |
| Φ11 反向芯片 | 60 | >1200 | 900 | ≤ 1.2 | <20 | <3 | <40 | | |
| Φ12.4 正向芯片 | 70 | >1000 | 1700 | ≤ 1.2 | <20 | <3 | <50 | | |
| Φ12.4 反向芯片 | 70 | >1000 | 1700 | ≤ 1.2 | <20 | <3 | <50 | | |
| Φ15.5 正向芯片 | 150 | >1600 | 2200 | ≤ 1.2 | <20 | <4 | <50 | | |
| Φ15.5 反向芯片 | 150 | >1600 | 2200 | ≤ 1.2 | <20 | <4 | <50 | | |

四、使用注意事项：

- 1、芯片从蓝膜上取下时，应用电热吹风对蓝膜加热后取下芯片。
- 2、建议用真空吸笔拿取芯片。
- 3、工作时应戴好口罩、静电手指套等防护用品。
- 4、严禁用手直接接触芯片。
- 5、蓝膜一旦揭掉，必须将本批芯片全部用完，防止氧化。



高温旋转整流二极管芯片产品说明书

一、芯片特点

- 1、采用沟槽氮化硅玻璃烧结工艺。
- 2、正向压降低，功耗小。
- 3、高温 200℃ 下反向漏电流小。
- 4、浪涌电流能力强。
- 5、反向恢复时间短，工作频率高。
- 6、芯片双面镍钛银金属化，牢固度强。
- 7、与正向芯片配合易于组装成三相桥电路。



二、主要用途：用于制作各种高温整流二极管，用于各种电器、电机及电子电路中整流用。

三、主要电特性：

| 型号 | 最大正向电流 I_F (A) | 最大反向重复峰值电压 V_{RRM} (V) | 最大浪涌电流 I_{FSM} (A) | 最大峰值电压 V_{FM} (V) | 最大反向漏电流 | | 反向恢复时间 (ns) | 工作结温 T_{jm} (°C) | 备注 |
|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | I_{R1} (μ A) (25°C) | I_{R2} (mA) (200°C) | | | |
| Φ6 反向芯片 | 10 | >800 | 200 | ≤ 1.4 | <5 | <3 | <300 | -55~ 200 | 芯片详细特性、外形尺寸以各芯片的规格书为准。 |
| Φ9 反向芯片 | 40 | >800 | 800 | ≤ 1.4 | <10 | <3 | <300 | | |
| Φ11 反向芯片 | 60 | >800 | 900 | ≤ 1.4 | <20 | <3 | <300 | | |
| Φ12.4 反向芯片 | 70 | >800 | 1700 | ≤ 1.6 | <20 | <4 | <500 | | |
| Φ15.5 反向芯片 | 150 | >800 | 2200 | ≤ 1.6 | <20 | <4 | <500 | | |

四、使用注意事项：

- 1、芯片从蓝膜上取下时，应用电热吹风对蓝膜加热后取下芯片。
- 2、建议用真空吸笔拿取芯片。
- 3、工作时应戴好口罩、静电手指套等防护用品。
- 4、严禁用手直接接触芯片。
- 5、蓝膜一旦揭掉，必须将本批芯片全部用完，防止氧化。